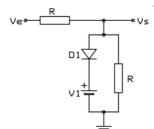
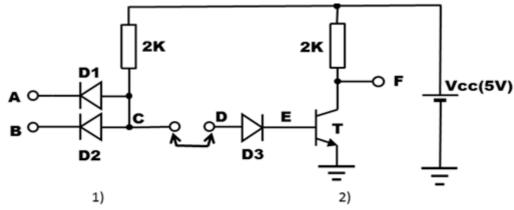
10 Qüestions de TEORIA (6 punts) . Puntuació: BÉ:+0.6 punts. MAL: -0.15 punts, N.C: 0

- En el circuit amb díodes de la figura, i per a les dades que s'indiguen, assenyale la resposta VERTADERA. DADES: Ve = 8V; V1= 2V; Díode D1: Vy = 0.7V
 - [A] Vs = 0V
 - [B] Vs = 2V
 - [C] Vs = 2.7V
 - [D] El corrent per les dos resistències és idèntic, ja que formen un divisor resistiu.



En el circuit de la figura hi ha dos subcircuits digitals fets amb díodes, transistors i resistències: el 1), amb entrades A i B, i eixida C; i el 2), amb entrada D, i eixida F. Suposant que es connecta C i D, assenyale la resposta FALSA:

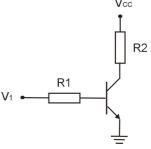
DADES: $V_{Y} = 0.7V$ (per a tots els díodes); $V_{BEON} = 0.7V$, $V_{CESAT} = 0.2V$ (per al transistor).



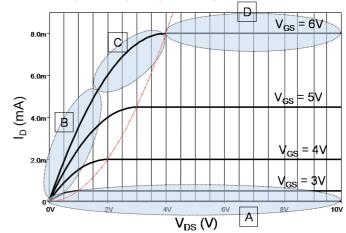
- [A] Quan les entrades són A = B = "1" (5V), llavors $V_C = V_D = 1.4V$.
- [B] Quan D1 i/o D2 condueix, llavors no pot conduir ni D3 ni el transistor.
- [C] Quan A ="1" i B = "0", $V_F = 0.2V$.
- [D] El circuit en conjunt actua com una porta NAND de les entrades.
- Es té un transistor bipolar de silici NPN en un circuit que es troba polaritzat en la regió de saturació y el seu corrent de col.lector és de 25mA. Indique quina de les següents afirmacions sobre aguest transistor és FALSA:

DADES: V_{BEON}=0.7V; V_{CESAT}=0.2V

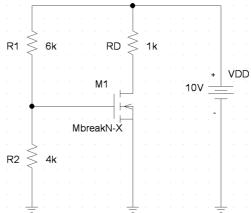
- [A] El seu corrent de col.lector és: $I_C = I_{E}-I_{B}$
- [B] El seu corrent de col.lector és: $I_C < \beta \times I_B$
- [C] La seua tensió col·lector-base és: V_{CB} = 0.5V
- [D] La potència que dissipa el transistor (P = I_C x V_{CE}) té un valor de 5mW, aproximadament.
- El circuit de la figura pot ser utilitzat com un inversor lògic, amb entrades de tensió de 0V i 5V corresponents al "0" i al "1" lògics, respectivament. ¿Quin serà el valor mínim que haurà de tindre R2 per a què el circuit treballe correctament en commutació? (es a dir, que puga assolir la saturació)
 - [A] $R2_{MIN} = 0.5k\Omega$ [B] $R2_{MIN}$ = $1k\Omega$
 - Dades: **ß**: 100
 - R1= $270k\Omega$ [C] $R2_{MIN} = 2k\Omega$
 - Vcc= 5V [D] R2_{MIN}= $3k\Omega$ V_{BEON} = 0.7, V_{CESAT} =0.2V



- 5. Referent al transistor MOSFET, indique la resposta FALSA.
- [A] En la zona òhmica, el corrent varia quadràticament en funció de V_{GS}
- [B] Els transistors MOSFET de canal N són més ràpids en la commutació degut a que els electrons tenen major mobilitat que els buits.
- [C] Per evitar la ruptura de la capa thinox del transistor, es sol utilitzar un circuit retallador a dos nivells en el terminal de porta, dissenyat amb díodes.
- [D] En los transistors PMOS, a partir d'un determinat potencial negatiu en V_{GS} es forma el canal per acumulació de buits, la qual cosa permet la conducció quan V_{DS} <0.
- 6. Donades les corbes del transistor MOSFET con les zones (A,B,C,D) indique la resposta FALSA.
- [A] En commutació, el transistor funciona alternativament entre les zones A i D
- [B] En la zona B, el transistor es comporta com una resistència variable en funció de V_{GS}.
- [C] En la zona B, a prop de l'origen, es pot utilitzar l'expressió òhmica aproximada: I_{DS≈2}K(V_{GS}- V_T)V_{DS}
- [D] La paràbola que delimita les zones C i D ve donada per l'expressió $V_{DS} = V_{GS}-V_T$



- 7. En el circuit de polarització de la figura, indique l'afirmació **CORRECTA** sobre el punt Q del transistor MOSFET. Paràmetres del transistor: $V_T = 2V$, $K = 2mA/V^2$
- [A] $V_{GS} = 6V$, $I_{DS} = 8mA$, $V_{DS} = 2V$
- [B] El transistor està tallat, perquè el corrent de porta és 0.
- [C] $V_{GS} = 4V$, $I_{DS} = 9mA$, $V_{DS} = 1V$
- [D] $V_{GS} = 4V$, $I_{DS} = 8mA$, $V_{DS} = 2V$



8. En les taules adjuntes s'indiquen algunes de les característiques elèctriques de dos famílies lògiques genèriques A i B. A partir d'elles, indique la resposta **CORRECTA** (la notació X→Y indica eixida X connectada a entrada Y):

Família A						
V_{IHmin}	V _{ILmax}	V_{OHmin}	V _{OLmax}			
2 V	2 V 0.8 V		0.5 V			
I _{IHmax}	I _{IHmax} I _{ILmax}		I _{OLmax}			
20 μΑ	- 0.36 mA	-400 μA	8 mA			
Família B						
V_{IHmin}	V _{ILmax}	V_{OHmin}	V _{OLmax}			
2 V 0.8 V		2.4 V	0.4 V			
I _{IHmax} I _{ILmax}		I _{OHmax}	I _{OLmax}			
40 μA - 1.6mA		-400 μA	16 mA			

- [A] El marge de soroll A→B és de 0.7 V.
- [B] El fan-out A→B és de 20.
- [C] El fan-out B→A és de 44.
- [D] El marge de soroll B→A és de 0.4V.

9. Es vol connectar una eixida TTL de col.lector obert amb una entrada CMOS alimentada a 12 V. Indique la resposta correcta:

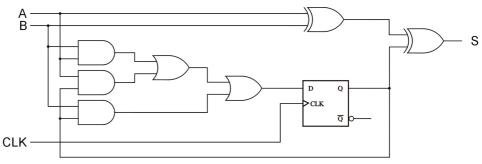
Família A (TTL col.lector obert)					
V _{OLmax}	I _{OHmax (fugas)}	I _{OLmax}			
0.4 V	100 μΑ	24 mA			

Família B (CMOS +12V)					
V_{IHmin}	V _{ILmax}	I _{IHmax}	I_{ILmax}		
8.4 V	8.4 V 3.6 V		-10 pA		

- [A] Cal afegir una resistència de pull-up connectada entre l'eixida i 12 V.
- [B] La connexió pot ser directa.
- [C] Es necessita un buffer TTL per poder subministrar el corrent necessari en les entrades CMOS.
- [D] Cal afegir una resistència de pull-up connectada entre l'exida i 5 V.
- 10. Donat el següent circuit seqüencial síncron, dissenyat amb portes i un biestable D, assenyale l'afirmació **CORRECTA** sobre la **freqüència màxima** de funcionament:

Parametres temporals: Biestables: (Set up: t_{su} = 5 ns, Hold: t_h = 2 ns, tp_{HL} = 20 ns, tp_{LH} = 18 ns), Portes: (tp_{HL} = 10 ns, tp_{LH} = 8 ns).

- [A] 22 Mhz
- [B] 55 Mhz
- [C] 40 Mhz
- [D] 18 Mhz



(PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO)

Cognoms:

Nom:

PROBLEMA (4 PUNTS)

El circuit digital de la Figura 1, dissenyat amb transistors MOSFET, te dos entrades (A, B) i una eixida (F).

Nota: En zona òhmica (lineal) utilitze l'expressió aproximada $R_{ON} \approx 1/(2K(V_{GS} - V_T))$

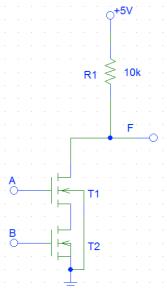


Figura 1

Paràmetres transistors:	
$V_T = 1 V$	
$K = 1 \text{ mA/V}^2$	

[A] (0.5 Punts) Replene la següent taula de veritat e indique l'expressió lògica de F en funció de les entrades A i B.

Α	В	F
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

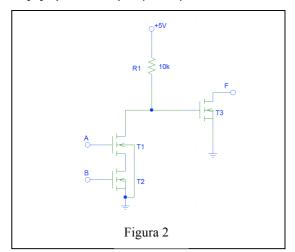
[B] (1.5 Punts) Supose que $V_A = V_B = 5V$ ("1" lògic). Nota: com el circuit és digital, els transistors funcionen en commutació, entre tall i zona lineal (R_{on}).

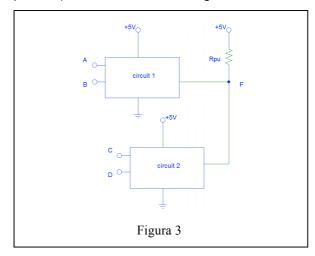
Dibuixe el circuit elèctric equivalent (substituïsca cada transistor per Ron o un interruptor obert) i realitze els càlculs necessaris per completar la taula següent. Considere la mateixa R_{on} per als dos transistors.

Complete la següent taula sobre el funcionament del circuit.

$R_{on}(k\Omega)$	Zona T1	Zona T2	V _F (Volt)	Consum estàtic (mW)

[C] (1.2 Punts) Supose que es modifica el circuit de l'apartat A) com es mostra en la Figura 2.





C.1) (0.2 Punts) Indique el tipus d'eixida del circuit modificat:

C.2) **(0.5 Punts)** Supose que es connecten 2 circuits como l'anterior (Figura 2), tal i com se mostra en la Figura 3 (cada caixa de la fig.3 representa un circuit idèntic al de la fig.2). Indique l'expressió lògica de F en funció de les entrades (A, B, C, D). Justifique breument la resposta.

F (A, B, C, D) = _____

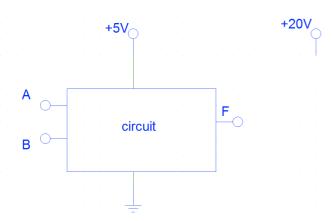
C.3) **(0.5 Punts)** Calcule el rang de valors admissibles per a Rpu (Rpu_{min} \leq Rpu \leq Rpu_{max}). Utilitze els següents paràmetres del fabricant:

 V_{OLmax} = 0.5V, V_{OHmin} = 4.5V, I_{OLmax} = 24mA, I_{OHmax} (fuites) = 100 μ A

_____ ≤ R_{pu} ≤ _____

[D] **(0.8 Punts)** Se desitja controlar l'encesa d'un LED con el circuit digital de la Figura 2. <u>Complete l'esquema</u> de la figura adjunta i calcule els elements externs necessaris.

El LED s'alimenta a +20V i té les següents característiques: I_{LED} = 20mA; V_{LED} = 2V.





A



DNI

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

- a b c d
- a b c d 2 - - - -
- a b c d
- a b c d
- a b c d
- a b c d
- a b c d 8 — — — —
- a b c d 9 - - - -
- a b c d
 10 - -

ETSINF - Tco

Examen Primer parcial - 25/04/2016

Apellidos

Nombre

Marque así Así NO marque

NO BORRAR, corregir con Typex